

# —先端半導体デバイスの基礎と応用小特集（英文論文誌C）論文募集—

先端半導体デバイスの基礎と応用小特集編集委員会

情報化社会の進展は、半導体集積回路・半導体デバイスの技術進歩無しには望めません。また、将来の知識基盤社会の構築にも、半導体デバイスの革新的な進歩に期待が寄せられています。微細化の限界を打破するためのシリコン ULSI デバイス技術、通信容量を格段に飛躍させる化合物半導体デバイス、新機能を創出する量子効果デバイスなど、半導体デバイスの大きな挑戦が進んでいます。最近では、化合物半導体とシリコンの融合集積化も研究が進められています。このような背景から、最先端半導体デバイスの研究動向を紹介することを目的に『先端半導体デバイスの基礎と応用』と題して小特集（2025年9月号）を企画致しました。多くの方々の積極的な御投稿をお願い致します。

## 1. 対象分野

- ・集積回路及び先端集積化技術
- ・集積回路プロセス技術
- ・高周波デバイスと回路応用
- ・パワーデバイス
- ・ワイドバンドギャップ材料とデバイス
- ・新しい材料、デバイス、回路
- ・半導体デバイス応用技術
- ・MOSFET、バイポーラトランジスタ、集積デバイス
- ・化合物半導体材料とデバイス応用
- ・マイクロ波/ミリ波デバイス
- ・TFTの材料・デバイス・応用
- ・量子効果デバイス、単電子デバイス
- ・評価技術・シミュレーション技術
- ・センサ・ディスプレイ

## 2. 論文の執筆と取扱い

通常の英文論文と同一です。刷り上がりペーパー8ページ、ブリーフペーパー4ページ以内（厳守）を原則とします。詳細は Information for Authors ([http://www.ieice.org/eng/shiori/mokuji\\_es.html](http://www.ieice.org/eng/shiori/mokuji_es.html)) を御参照下さい。査読後の再提出期間(通常は60日)を短縮する場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。投稿方法は下記を御参照下さい。

## 3. 投稿方法

査読作業の円滑化を図るため、本小特集では論文の電子投稿を行います。以下の手順で御投稿下さい。  
[https://review.ieice.org/regist/regist\\_baseinfo\\_e.aspx](https://review.ieice.org/regist/regist_baseinfo_e.aspx) より登録を行って下さい。また、Web上で著作権の譲渡手続きを行って下さい。なお登録時には必ず"Journal/Section"で[Special-FU] Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices を選択して下さい。[Regular-EC]を選択しないで下さい。

## 4. 論文投稿締切日 2024年8月31日（土）厳守

## 5. 問合せ先

二瀬 卓也（ウェスタンデジタル）  
E-mail: [takuya.futase\[atmark\]wdc.com](mailto:takuya.futase[atmark]wdc.com)

## 6. 小特集編集委員会

委員長／ゲストエディタ：宇佐美達矢（ラピダス）

幹事：二瀬卓也（ウェスタンデジタル）

委員：平野博茂（タワーパートナーズセミコンダクター）、野田泰史（パナソニック）、細井卓治（関西学院大）、池田浩也（静大）、浦岡行治（奈良先端大）、大野裕三（筑波大）、岡田浩（豊橋技科大）、葛西誠也（北大）、小林伸彰（日大）、佐久間究（キオクシア）、佐道泰造（九大）、品田高宏（東北大）、須原理彦（東京都立大）、田中一（阪大）、野口隆（琉球大）、野村晋太郎（筑波大）、平本俊郎（東大）、松田直樹（産総研）、宮崎誠一（名大）、森貴洋（産総研）、諏訪智之（東北大）

## 7. 重要なお知らせ

- ・論文採録の場合は掲載料が必要となりますので、あらかじめ御了承下さい。
- ・AWAD2024で発表された論文を含め一般投稿を広く受け付けます。
- ・投稿に際しては、著者のうち少なくとも1名は本会会員でなければなりません。ただし招待論文に関してはこの限りではありません。必要な投稿資格を満たしていない著者からの投稿論文については、投稿を受け付けないこととなりますので御注意下さい。入会の案内はこちらを御覧下さい。

<http://www.ieice.org/jpn/nyukai/index.html>